◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-2515

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月8日

G 02 F 1/1337

5 2 0

8806-2H 8806-2H

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁)

9発明の名称

液晶用配向膜の製法

②特 顧 昭63-148542

20出 願 昭63(1988)6月16日

司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 個発 明 添 憧 山 者 @発 明 Œ 晋 吾 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 者 藤 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 朗 72)発 明 者 炭 B 祉 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 \blacksquare 勲 夫 ⑦発 明 者 太 大阪府門真市大字門真1006番地 の出 頭 人 松下電器産業株式会社

個代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 細 む

1、発明の名称

液品用配向膜の製法

- 2、特許請求の範囲
 - (i) X線レジスト層を主面に有する基板に平行 X 線を前記基板に所定の角度に照射し、次に現像 液、リンス液に浸描することを特徴とする液晶 用配向膜の製法。
- (2) X線レジスト層を主面に打する基板に平行X線を前記基板に所定の角度に削引し、次に現像液、リンス液に浸渍し、更に乾燥後、前紀X線レジスト層をラピングすることを特徴とする液高用配向膜の製法。
- (3) 平行 X線の削射強度の空間的分布をマスクを 用いて、変調することを特徴とする請求項(1)ま たは(2)のいずれかに記載の液品用配向膜の塑性。
- (4) マスクはポリイミド・フィルムやマイラー ・フィルムの上にX線を吸収する企画を積層し、 サンド・プラスト法、液体ホーニング法、研磨 法によって前記金銭に傷を生起させることによ

っていることを特徴とする請求項(1)または(2)の いずれかに記載の液晶用配向酸の製法。

- (5) 平行X線が凝が、原子からの特性X線による ことを特徴とする請求項(1)または(2)のいずれか に記載の液晶用配向膜の養法。
- 登明の詳細な説明 3、発明の詳細な発明

庶衆上の利用分野

本発明は、高分子制脂からなる液晶分子の配向 脱の気法に関する。

従来の技術

液品分子の配向膜は、液品ディスプレイには必須のものである。前記配向膜としては、無機質の針方誘数膜、ラピングされた有機樹脂膜等が使われる(例えば液晶エレクトロニクスの基礎と応用、佐々木 昭夫 編)。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、無機関の針方筋着膜については、 製置が比較的高値なこと、真空プロセスなのでプロセス・コストが高くつくことに繋がある。

一般にラピング法が産業界では多用されている

が、液晶分子のはり角の大きいモード、すなわち スーパー・ツィスティッド・ネマティック・モー ドでは、ラビング圧が軽く、密度の高いラビング が必要となる。この条件を得るためには、磁格な 管理が必要となる。

さらに、スーパー・ツイスティッド・ネマティック・モードを用いた大容量表示においては、液晶分子のプレ・チルト角を大きくする必要がある。今のところ、一致した考えは無いか、プレ・チルト角としては、15°~20°は欲しい。現在、配向設材料として有機樹脂を用いた場合、ラピングにおいては、再現性と信頼性を考慮すると、約10°が限度である。

課題を解決するための手段

本発明は前述のような課題を解決するために、 X線レジスト層を主面に有する基板に平行X線を 前記基板に所定の角度に関射し、次に現像液、リ ンス被に浸漬するような液品用配向膜の製法を提 供するものである。

本苑明は前途のような課題を解決するために、

膜の製法を提供するものである。

作用

液晶分子を配向させるためには、器型界面での液晶分子を配向させる必要がある。このために、 界面に通常、配向膜が設けられる。配向膜の変質は、分子レベル程度にミクロなある秩序が必要なのは理解される。この秩序は、液晶分子と相互作用する基が規則的に並んでいる場合もあるし、凸凹形成が規則的であって、結果として体積排除効果による自由エネルギー減少のにより液晶分子に配向規制力を課することもあると考えられている。本発明はこれらの配向メカニズムに関与していると考えられる。

X 線は放長が0.1 オングストローム~100 オンストロームの電極波であって、このうちでも、 飲 X 線(放長 4 ~50 オンストローム)のものが、 より使い扱い。

特性X類とは、たとえば金属ターゲットに電子 線を衝突させると、金属原子の内敷電子が原子か ら飛び出し、次の過程で外殻電子が抜けた内殻電 X級レジスト層を主師に有する基板に平行 X線を向記基板に所定の角度に放射し、次に現像液・リンス液に設置し、更に乾燥後、向記 X線レジスト層をラピングするような液晶用配向膜の製法をも優価するものである。

また、本発明は前途のような課題を解決するために、前に述べた平行 X 線の限射において、照射強度の空間的分布をマスクを用いて、変調することを特徴とする液晶用配向膜の製法をも提供するものである。

また、本発明は前述のような課題を解決するために、マスクはポリイミド・フィルムやマイラー・フィルムの上にX線を吸収する金額を積層し、サンド・ブラスト法、液体ホーニング法、研密法によって前記金属に傷を生起させることによっていることを特徴とする前述の様な液晶用配向膜の製造を提供するものである...

本発明は向遠のような課題を解決するために、 向遠の平行紫外線光がエキシマー・レーザーから 得られることを特徴とする向遠の様な液晶用配向

子の穴に落込み、この時エネルギーがほとんど一定のX線が放射される。このX線は輝線スペクトル的である。

半導体技術で使うX線レジストとしては、 PMMAやCMSが公知である。

X級によりX級レジスト野が感光し、現像液、リンス液中への浸漬により、X線レジスト表面に 凸凹が出来、液晶分子が配向すると想定される。 X線を斜めに限射することにより、振晶分子の プレ・チルト角が大きくなるという結果を生んで いると推測している。また、X線レジストの感光、 現像や止の後、ラビングすることにより、 液晶分子のプレ・チルト角の調整、配向規制力の 強化を招来する傾向にあった。

向記平行X級光の敬梱な空間的分布をもたせることは、多分、起こっていると思われる光学系自身の乱れに由来する光源の性質を利用するか、またはより効果的には、基板上の有機樹脂層に密着させたマスクを利用する。

このように微観なパターンのマスクは、人手が 困難である。ほぼ、1ミクロン口に、数個以上の 白パクーンが必要である。これは、例えば、以下 の様にして得ることが出来る。金属枠に、マイラ ー・フィルムまたはポリイミド・フィルムを引き 延ばして固定する。このフィルムに付着力の強化 のために、クロムを約100オングストロームス パックー法で形成し、次に同様の方法で金額を約 2ミクロン形成する。 贝に、瓜曽粒子を使ったサ ンド・ブラスト法によって、または液体ホーニン グ法によって、または酸化クロム粒子等を使った 研密法により無数の傷を前記クロム階と金属に発 生させ、精果的に無数の白パターンを有するマス クを得る。サンド・プラスト法や液体ホーニング 法においては、粒子の関射角度を変えることによ り、平均的な白パターンの形状が変化し、ひいて は波晶分子の配向性やプレ・チルト角に影響を与 άZ.

本発明による方法は、真空を必要とせず、この 点、設備費は小さい。また、従来の繊維等による

強度がかなりのものになるように、管電圧を上げ て使用した。

第1図に封じ込みフィラノントX線管の構成所 面図を示す。1は冷却水、2は胴、3はシリコン・ターゲット、4はX線、5は電子、6はタングステン・フィラメント、7はベリリウム窓、8はガラスである。

(実施例1)

第2図に、 X 線の設計装置の概略図を示す。同図において、 1 1 は X 線線、 1 2 は ステンレスから出来たスリット、 1 3 はマスク、 1 4 は X 線レジスト層、 1 5 は 3 仮であり、 a は 3 仮 法 線と X 線のなす 角度である。 なお、 大面積に X 線を照射するためには、 3 仮は 情勢させる。 3 仮 とマスクの 密着は 该正による。

第2図の如く、ただしaは0°とし、マスク 13は省6、直後X線を、X線レジスト層を主面 上に有するガラス悲切に、すなわちX線レジスト 層に10分解射した。更に、現像液、及びリンス 液に设績し、その後エアー・ナイフで乾燥させた。 目脂膜のラピングにおいては、ネマチック液晶分子のプレ・チルトを若干、水平より立てようとすると、非常に強妙な条件設定と、間脂酸材料の選定が必要である。水発明による方法では、従来よりプレ・チルト角を大きく出来、再現性も向上し、また間脂膜材料の選択の自由度も広がった。

また、本発明において、X協盟射、現像の後、 ラピングするのは、基板近傍の被晶分子の並びの 方向性を強めるためのもので、従来に比べて、よ り大きなブレ・チルト角とか、安定性等の本発明 の効果は損なわれない。

実施例

X 垜淑としては、封じ込みフィラメント雄管 (水冷式)を用いた。ターゲットにはシリコンを はめ込んだ。シリコンの特性 X 線(Si-K)の

次に、通常の方法で、レーヨン布を使って軽いラ ピングを行なった。

この様な悲仮2枚を、液晶分子がホモジニアス配向になるように貼り会わせ、液晶を性入し、液晶パネルを得た。磁場法によるプレ・チルト測定の結果、12~13°のプレ・チルトが得られた。 実際のパネルにおいても、従来に比べて液晶分子のツイストにおける控れ安定性は何上した。

(実験例2)

実施例」と同様のプレ・チルト測定の結果、プレ・チルトは 15°以上であることが分かった。 実際のスーパー・ツイスティッド・ネマチック・パネル (STNパネル) においては、簡単な検討 の結果は総合的に特性が向上することを示唆している。

(実施例3)

前記マスクを以下の如く、作製した。ステンレス枠に2:5ミクロンの厚みのポリイミド・フィルムを引っ張りながら、張り付けた。次に、スパッター法で、クロムを約100オングストローム、 更に金を約2ミクロン積度した。

この金属間に単層粒子を使ったサンド・ブラスト法により、無数の傷を付けた。第3回にサンド・ブラスト法を行う装置の機略図を示す。21は 高圧空気を送るパイプ、22は重音粒子を入れた 容器、23は粒子の吹き出し口、24は金属層、 25はポリイミド・フィルム等からなる基体であ り、またりは粒子の吹き出し方向と基板の法線と のなす角である。

本実施例では、第3図bは0°とした。

つぎに実施例1の如く、ただしマスクを用いて、このマスクの金属の面をX線レジスト層に密着させて、X線レジスト層にX線を照射した。第2図において、角度aは0°及び30°のもの、2条件について試みた。更に、現像液、及びリンス液

角を測定したところ、その値は15°~30°の間にあり、これに至る諸条件に依存していた。 耶 現性は十分、保証されていた。

STNパネルにおいては、指特性は優れたものであった。

(変施例5)

マスクを以下のように製作した。実施例3の様に、ポリイミド・フィルム上にクロムと金の間を形成し、1ミクロン以下の粒径のアルミナを使った液体ホーニング、または酸化クロムを使った研究により、前記金属間に無数の傷を生起させた。このとき、液体ホーニングの場合には、粒子の肉には、では、研究の場合には、びか方のはないない場合とについて検討を有する条件と、そうでない場合とについて検討を加えた。このマスクを用いて、実施例3、実施例4と同様の試みをなした。結果は総合的に判断して、優れたものであった。

発明の効果

以上本発明は液晶分子配向用酸を得るための方

に設置し、その後エアー・ナイフで乾燥させた。 この後、通常のラピングを、樹脂層にラピング強 度を小さくして行った。

液晶パネルを作製し、液晶分子のプレ・チルト 例を測定したところ、その値は15°~30°の 間にあり、これに至る諸条件に依存していた。再 現性は十分、保証されていた。

STNパネルにおいては、語特性は優れたものであった。

(実施例4)

実施例3の如く、マスクを作製した。ただし、 低層粒子をクロム面に対して、第3図においても が約70°になるようにした。

つぎに実施例1の如く、ただしマスクを用いて、このマスクの金属の面をX線レジスト層に密着させて、X線レジスト層にX線を限射した。第2図において、角度aは0°及び30°のもの、2条件について試みた。更に、現像液、及びリンス液に浸漬し、その後エアー・ナイフで乾燥させた。

波晶パネルを作襲し、液晶分子のプレ・チルト

法を提供するものであり、産業上の価値は大なる ものがある。

4、図前の簡単な説明

第1図はX線管の構成断面図、第2図はX線照射装置の機略構成図、第3図はサンド・ブラスト 法を行う装置の優略構成図である。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほかし名

